



中国有色金属学会

THE NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA



首 页 | 学会简介 | 组织机构 | 学术活动 | 国际交流 | 期刊出版 | 教育培训 | 科学普及 | 成果奖励 | 专家库

第十一届全国MOCVD学术会议征文第一轮通知

举办时间：2010年1月12日-15日

会议地点：苏州

主办单位：中国有色金属学会

承办单位：中国科学院半导体研究所

国家半导体照明工程研发及产业联盟

协办单位：苏州吴中经济开发区管理委员会

顾问委员会委员：（按姓氏笔划排序）

王占国	王启明	牛憨笨	甘子钊	李晋闽	刘颂豪	孙祥祯
吴 玲	汤子康	沈家聪	陈良惠	郑有料	金亿鑫	闵乃本
陆大成	杨树人	段树坤	秦国刚	高鸿楷	徐叙榕	蒋民华

组织委员会：（按姓氏笔划排序）

主任委员：

王国宏 阮 军

委 员：

王 钢	王向武	王晓亮	申德振	叶志镇	江风益	刘纪美
刘 胜	杨 辉	陈文浚	杜国同	宋炳文	吴向方	张国义
张 荣	李 刚	董志江	沈光地	范玉钵	罗 毅	孟广耀
赵 毅	范广涵	梅 霆	周均铭	徐现刚	曾一平	沈 波
郝 跃	傅竹西	潘 毅	孙 明	江忠永	郝茂盛	廖奇为

秘书处：

论文征集：赵丽霞 冉 平

参会组织：刘 辉 王薇薇

会议宗旨：

本届会议旨在展示我国在金属有机化学气相淀积（MOCVD）技术领域研发的新理论、新进展，及其在材料应用领域的新动态、新成果，为我国从事MOCVD技术研发以及相关材料和器件研究的科研人员提供相互了解和交流的机会，探讨目前存在的问题和以后的主要发展方向，促进与MOCVD相关上中下游产业界的沟通与合作，进一步加快我国MOCVD技术创新及该技术的推广应用。

殷切希望国内外从事MOCVD及相关领域的专家、学者、科研技术人员、学生踊跃投稿，产业界人士积极参加会议，并提供与MOCVD技术相关的工作进展及产业概况的信息图片和资料。凡符合会议议题而且未在国内外学术刊物或会议上发表过的论文均可投稿。所有论文将编入会议文集，优秀论文将推荐到相关期刊上发表。

征文内容：

1、设备的研制与开发

Research and Development of MOCVD system

2、MO源、衬底等基础材料

MO Source, Substrate materials

3、III-V族化合物材料的生长和制备

Growth and Fabrication of III-V Compound Semiconductors

4、生长机理和动力学研究

5、II-VI族及其化合物材料生长和制备

Growth and Fabrication of II-VI Compound Semiconductors

6、其他相关技术

Other Related Techniques

征文要求:

会议论文摘要及回执(附件1)务必在2009年11月13日前通过Email(推荐)或传真提交会议组委会秘书处。论文需电子版一份,中文稿件皆可;论文摘要一般为A4纸,具体请参见征文模板(附件3)。会议筹备组将根据摘要内容确定交流类型,并编撰会议文集。

会议组委会秘书处联系方式:

论文征集:中国科学院半导体研究所

地 址:北京市海淀区清华东路甲35号(100083)

联系人:赵丽霞 冉 平

电 话:010-82304053, 82305461 传 真:010-82305245

电子邮件:ghwang@semi.ac.cn, lxzhao@semi.ac.cn

参会组织:国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)

地 址:北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦B座702室(100086)

联系人:刘 辉 王薇薇

电 话:010-51727119, 51727115 传 真:010-82512803

电子邮件:liuh@china-led.net, wangww@china-led.net

- 附件 1. 第十一届全国MOCVD学术会议回执
2. 全国第十一届MOCVD会议赞助单位表
3. 第十一届全国MOCVD学术会议征文要求